

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SU**
Mã hồ sơ:



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng trống: □)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng □

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

1. Họ và tên người đăng ký: Lương Thị Kim Phương

2. Ngày tháng năm sinh: 15/3/1981; Nam □; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Phật giáo

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh):

SN 51 đường Trần Huy Liệu, Phố Nam Cao, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Lương Thị Kim Phương, SN 51 đường Trần Huy Liệu, Phố Nam Cao, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại nhà riêng:; Điện thoại di động: 0904621503;

E-mail: luongthikimphuong@hdu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

- Từ năm 2003 đến năm 2004: Giáo viên trường THPT Yên Định 1, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá

- Từ năm 2004 đến năm 2007: Giáo viên trường THPT Thiệu Hoá, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

- Từ năm 2007 đến nay: Giảng viên trường Đại học Hồng Đức

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng phòng QLĐT Sau đại học;

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng bộ môn Vật lý kỹ thuật

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Hồng Đức

Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại cơ quan: (0237)3910222

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng năm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Học vị: Tiến sĩ

- Được cấp bằng ĐH ngày 08 tháng 04 năm 2003, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Su phạm Vật lý

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Hồng Đức

- Được cấp bằng ThS ngày 09 tháng 05 năm 2007, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Viện ITIMS, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Được cấp bằng TS ngày 18 tháng 01 năm 2015, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Khoa học vật liệu, Vật lý, Hoá học và Khoa học Nano.

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Aix-Marseille, cộng hoà Pháp

- Được cấp bằng TSKH ngày ... tháng ... năm ..., ngành:, chuyên ngành:

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước):

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS

ngày tháng năm,

ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh tại HĐGS cơ

sở:

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh tại HĐGS ngành, liên

ngành:

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu về vật liệu quang Ge/Si ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp

- Nghiên cứu về vật liệu sắt điện không chì $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$ dung dịch rắn với MTiO_3 (M là kim loại chuyển tiếp)

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);

- Đã hoàn thành (số lượng) 02 đề tài NCKH cấp nhà nước (đề tài Nafosted);

- Đã công bố (số lượng) 27 bài báo KH, trong đó 10 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín có chỉ số ISI/Scopus;

- Đã được cấp (số lượng) bằng chế, giải pháp hữu ích;

- Có 01 chương sách được Nhà xuất bản quốc tế ấn hành:

Luong Thi Kim Phuong, “Silicon Materials”, *Intechopen* (2019) ISBN 987-1-78984-659-1.

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất

[1]. **T. K. P. Luong**, M. T. Dau, M. A. Zrir, M. Stoffel, V. Le Thanh, M. Petit, A. Ghrib, M. El Kurdi, P. Boucaud, H. Rinnert, and J. Murota “Control of tensile strain and interdiffusion in Ge/Si(001) epilayers grown by molecular-beam epitaxy”, *Journal of Applied Physics* 114, 083504 (2013). (*tạp chí quốc tế có chỉ số ISI; IF= 2,185*)

- [2]. **T.K.P. Luong**, A. Ghrib, M.T. Dau, M.A. Zrir, M. Stoffel, V. Le Thanh, R. Daineche, T.G. Le, V. Heresanu, O. Abbes, M. Petit, M. El Kurdi, P. Boucaud, H. Rinnert, J. Murota, “Molecular-beam epitaxial growth of tensile-strained and n-doped Ge/Si(001) films using a GaP decomposition source”, *Thin Solid Films* 557 (2014) 70–75 (*tạp chí quốc tế có chỉ số ISI; IF= 1,867*)
- [3]. **T K P Luong**, V Le Thanh, A Ghrib, M El Kurdi and P Boucaud, “Enhanced Tensile Strain in P-doped Ge Films Grown by Molecular Beam Epitaxy Using GaP and Sb Solid Sources”, *Journal of Electronic Material* (2019) (*tạp chí quốc tế có chỉ số ISI; IF= 1,566*)
- [4]. **T K P Luong**, V Le Thanh, A Ghrib, M El Kurdi and P Boucaud, “The efficiency of carbon adsorption as a diffusion barrier in Ge/Si heterostructures”, *Physica Scripta*. 94 (2019) 085803 (6pp) (*tạp chí quốc tế có chỉ số ISI; IF=1,902*)
- [5]. **Luong Thi Kim Phuong**, Mohammad Zrir, “Suppression of out-diffusion effect of dopants by the HfO₂ diffusion barrier for highly n-doped ge epilayers grown on Si(001) substrate”, *Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên*. 181 (2018) 99 –103
 Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác giả, NXB, năm XB, chỉ số ISBN; với công trình KH: ghi rõ tên công trình, tên các tác giả, tên tạp chí, tập, trang, năm công bố; nếu có thì ghi rõ tạp chí thuộc loại nào: ISI (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI), Scopus hoặc hệ thống CSDL quốc tế khác; chỉ số ảnh hưởng IF của tạp chí và chỉ số trích dẫn của bài báo.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Chiến sỹ thi đua cấp trường năm học 2014- 2015; được Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trao tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ các năm học: 2014-2015; 2015-2016; 2017-2018; 2018-2019.

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Không

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá).

Trong 12 năm công tác kể từ năm 2007, tôi đã giảng dạy nhiều học phần chuyên ngành Vật lý cho sinh viên chính quy và học viên cao học của trường Đại học Hồng Đức. Tham gia phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của người giảng viên. Bên cạnh đó, tôi đã tích cực trau dồi khả năng ngoại ngữ và đã được nhận học bổng tiến sĩ của chính phủ Việt Nam (theo đề án 322) tại cộng hòa Pháp. Tôi đã cố gắng vượt khó, thu xếp việc gia đình để hoàn thành luận án tiến sĩ tại Pháp trước thời hạn 09 tháng và trở về trường Đại học Hồng Đức công tác. Tôi luôn cập nhật kiến thức mới và áp dụng các phương pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy các học phần ở bậc đại học và sau đại học. Tích cực tham gia các hội thảo quốc gia, quốc tế để tiếp thu những kiến thức mới và các xu hướng nghiên cứu trên thế giới. Từ tháng 4/2014-12/2016 với tư cách là Phó trưởng bộ môn Vật lý kỹ thuật và được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Vật lý chất rắn, tôi luôn sát sao với công việc từ việc tuyển sinh, cho đến việc giảng dạy và hướng dẫn luận văn thạc sĩ. Bên

cạnh đó, để nâng cao chất lượng đào tạo của chuyên ngành thì tôi đã chủ trì việc cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Vật lý chất rắn. Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giảng viên và xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn của chức danh Phó giáo sư, mong muốn được công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

Tổng số 12 năm.

(Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ)

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		HD luận văn ThS	HD đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH	Giảng dạy		Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2010-2014							Đi NCS tại Pháp
2	2014-2015					117	67,5	184,5/285
3	2015-2016					153	67,5	247,5/321
3 năm học cuối								
4	2016-2017			01			67,5	67,5/135 (nghỉ sinh 06 tháng)
5	2017-2018			02			67,5	67,5/230
6	2018-2019			01			202,5	202,5/285

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh (Toefl IBT 70); Tiếng Pháp (TCF 331)

- Học ĐH ; Tại nước:; Từ nămđến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Pháp năm 2014

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:số bằng:; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : Tiếng Anh chuyên ngành

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường đại học Hồng Đức

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Toefl IBT 70

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng)

TT	Họ tên NCS hoặc HV	Đối tượng		Trách nhiệm HD		Thời gian hướng dẫn từ đến ...	Cơ sở đào tạo	Năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HV	Chính	Phụ			
1	Nguyễn Trung Hiếu		x	x		12/2015-6/2016	Đại học Hồng Đức	2017
2	Lê Trung Dũng		x	x		01/2017-7/2017	Đại học Hồng Đức	2018
3	Lưu Thị Minh Phương		x	x		01/2017-7/2017	Đại học Hồng Đức	2018
4	Trịnh Trúc Ly		x	x		12/2017-6/2018	Đại học Hồng Đức	2018

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Viết MM hoặc CB, phần biên soạn	Xác nhận của CSGDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
1						
2						
...						

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS):

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)
1	Nghiên cứu chế tạo màng mỏng epitaxy Germani	Chủ nhiệm	103.02-2015.106	36 tháng (05/2016-05/2019)	19/6/2019

	trên Silic có ứng suất căng và pha tạp điện tử với mật độ cao nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp		Cấp nhà nước (Nafosted)		
2	Nghiên cứu, tổng hợp các màng đa lớp Ge _{1-x} Mnx/Ge có cấu trúc dạng cột nano và nhiệt độ Curie cao cho các ứng dụng spintronics.	Thành viên	103.02-2013.66 Cấp nhà nước (Nafosted)	24 tháng 2014-2016	07/7/2016
...					

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)

7.1.1. Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Vai trò	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/số	Trang	Năm công bố
1	Silica-Aluminar xerogel đồng pha tạp Er ³⁺ và Yb ³⁺ : quá trình chế tạo và các tính chất	05	Đồng tác giả	Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ VI			Tập 1	370-373	2005
2	Màng dẫn sóng phẳng SiO ₂ -TiO ₂ -B ₂ O ₃ pha tạp Er ³⁺ quá trình chế tạo và các tính chất	05	Đồng tác giả	Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ V				632-635	2007

3	The effects of Mn concentration on structural and magnetic properties of $\text{Ge}_{1-x}\text{Mn}_x$ diluted magnetic semiconductors	08	Đồng tác giả	Journal of Physics	ISI (IF: 2,168 Q2)	9	292	012012	2011
4	Germanium band gap engineering induced by tensile strain for Si-based optoelectronic applications	02	Tác giả chính	Communication in Physics			23/ 4	367-375	2013
5	Control of tensile strain and interdiffusion in Ge/Si(001) epilayers grown by molecular-beam epitaxy	11	Tác giả chính	Journal of Applied Physics	ISI (IF: 2,185 Q2)	53	114	083504	2013
6	Molecular-beam epitaxial growth of tensile-strained and n-doped Ge/Si(001) films using a GaP decomposition source	15	Tác giả chính	Thin Solid film	ISI (IF: 1,867 Q2)	21	557	70–75	2014
7	Epitaxial growth of high curie temperature $\text{Ge}_{1-x}\text{Mn}_x$ quantum dots on si(001) by self-assembly	02	Tác giả chính	Communication in Physics			24	69-77	2014

7.1.2. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ

TT	Tên bài báo	Vai trò	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF)	Số trích dẫn của	Tập/số	Trang	Năm công bố
----	-------------	---------	------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------	--------	-------	-------------

						bài báo			
1	Highly-doped, highly-strained Germanium and schottky Electroluminescent diodes	Đồng tác giả	16	ECS transaction, The electrochemical society	ISI IF:3,266 Q2		64	359-364	2014
2	Making germanium, an indirect band gap semiconductor, suitable for light-emitting devices	Tác giả chính	05	Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	Scopus	10	6	015013	2015
3	The effect of carbon element on optical properties of n-doped Ge on silicon substrate	Tác giả chính	01	<i>Modern Physics Letter B</i>	ISI IF:0,731 Q4		32	1850224	2018
4	A New Approach for Heavy N-Doping Process in Ge Epilayers Using Specific Solid Source	Tác giả chính	01	<i>Optics and Photonics Journal</i>		1	8	11-19	2018
5	Khống chế sự hình thành tầng trưởng dạng đảo của germani trên đế siclic bằng phương pháp epitaxy chùm phân tử	Tác giả chính	01	<i>Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên</i>			181	35-40	2018
6	The suppression of out-diffusion effect by the HfO ₂ diffusion barrier for highly n-doped Ge epilayers grown on Si(001) substrate	Tác giả chính	02	<i>Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên</i>			181	99-103	2018
7	Ảnh hưởng của nồng độ ion Al ³⁺ và điều kiện công nghệ tới tính chất quang của màng silica- titania pha tạp ion Er ³⁺ ứng dụng trong quang dẫn song	Tác giả chính	02	<i>Tạp chí Khoa học, Đại học Hồng Đức</i>			39	120	2018
8	Optical Properties of Sb Doped Ge Films Deposited on Silicon Substrate by Molecular Beam Epitaxy	Tác giả chính	06	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics			34	48-54	2018

9	Phương pháp xử lý bề mặt đế silic ở nhiệt độ thấp ứng dụng trong kỹ thuật tăng trưởng epitaxy chùm phân tử	Tác giả chính	01	<i>Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên</i>			185	57-62	2018
10	Nghiên cứu sự phân bố của các nguyên tử phốt pho pha tạp trong màng ge tăng trưởng epitaxy trên đế si(100) bằng kỹ thuật chụp cắt lớp đầu dò nguyên tử	Tác giả chính	01	<i>Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên</i>			189	79-84	2018
11	Tunable magnetic properties of $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$ materials via solid solution of NiTiO_3	Đồng tác giả	07	Applied Physics A	ISI IF:1,604 Q2		124	588	2018
12	Nghiên cứu tính chất quang của màng silica-titania-alumina pha tạp Er^{3+} ứng dụng trong dẫn sóng phẳng	Tác giả chính	02	<i>Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng</i>			3	104	2018
13	Enhanced Tensile Strain in P-doped Ge Films Grown by Molecular Beam Epitaxy Using GaP and Sb Solid Sources	Tác giả chính	05	<i>Journal of Electronic Material</i>	ISI IF:1,566 Q2		49	4674	2019
14	The efficiency of carbon adsorption as a diffusion barrier in Ge/Si heterostructures	Tác giả chính	05	Physica scripta	ISI IF:1,902 Q2		94	085803	2019
15	Magnetic properties of $(1-x)\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3+x\text{MnTiO}_3$ materials	Đồng tác giả	07	Journal of Magnetism and Magnetic Materials	ISI IF:3,046 Q1		471	164	2019
16	Nghiên cứu chế tạo diode phát quang trên nền vật liệu Ge/Si pha tạp điện tử mật độ cao ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp	Tác giả chính	01	<i>Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên</i>			204(11)	17-22	2019

17	Ảnh hưởng của nguyên tố Sb đến tính chất quang của màng Ge/Si đồng pha tạp Sb và P	Tác giả chính	01	Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức			Chấp nhận đăng		2019
18	Ảnh hưởng của điều kiện xử lý nhiệt đến tính chất quang của màng Ge/Si đồng pha tạp Sb và P	Tác giả chính		Tạp chí khoa học, Đại học Duy Tân			03(34)	10-15	2019
19	Nghiên cứu tính chất điện của màng Ge pha tạp điện tử từ nguồn rắn GaP và Sb bằng phương pháp epitaxy chùm phân tử	Tác giả chính	01	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên			Chấp nhận đăng		2019
20	Ảnh hưởng của định hướng để lên sự hình thành các màng GeMn	Đồng tác giả	02	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên			Chấp nhận đăng		2019

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS: 07 bài

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Số tác giả
1				
2				
...				

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...)

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
1				
2				
...				

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học

- Chính sửa chương trình đào tạo thạc sĩ Vật lý chất rắn

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín:

- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS:
- Giờ chuẩn giảng dạy:
- Công trình khoa học đã công bố:
- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Hướng dẫn NCS,ThS:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 07 năm 2019

Người đăng ký



Lương Thị Kim Phượng

D. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU NƠI ĐANG LÀM VIỆC

- Về những nội dung “Thông tin cá nhân” ứng viên đã kê khai:

Những thông tin cá nhân của giảng viên Lương Thị Kim Phượng đã kê khai là chính xác, đầy đủ và trung thực.

- Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này:

Giảng viên Lương Thị Kim Phượng công tác tại Trường Đại học Hồng Đức từ tháng 8 năm 2007. Với 12 năm công tác tại trường, giảng viên Lương Thị Kim Phượng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao từ việc hoàn thành định mức giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác. Giảng viên Lương Thị Kim Phượng luôn xây dựng và giữ vững phong cách chuẩn mực của một giảng viên đại học, nghiêm túc, tận tình, và có trách nhiệm với người học, được người học quý mến, kính trọng. Với một tinh thần làm việc nghiêm túc, giảng viên Lương Thị Kim Phượng đã có công bố nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín, và nhiều năm học được Nhà trường tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ.

(Những nội dung khác đã kê khai, ứng viên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật).

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 07 năm 2019



TS. Hoàng Nam